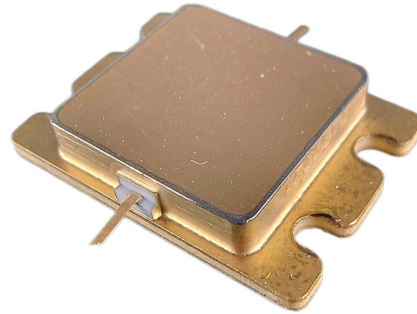


**产品特性：**

工作频率 2.70~3.70GHz

饱和输出功率  $P_{sat} \geq 52\text{dBm}$ 功率增益  $\text{Gain} \geq 12\text{dB}$ 工作效率  $\eta \geq 50\%$ 端口匹配  $Z_{in}/Z_{out}=50\Omega$ **产品说明：**

HXN40033是一款氮化镓内匹配功率管，采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺，产品的典型工作频带为2.7~3.7GHz，具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点，能够广泛应用于各种射频/微波系统中。

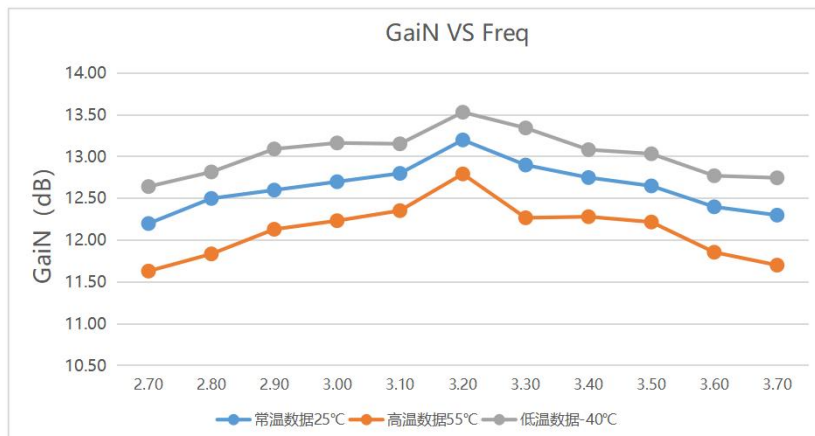
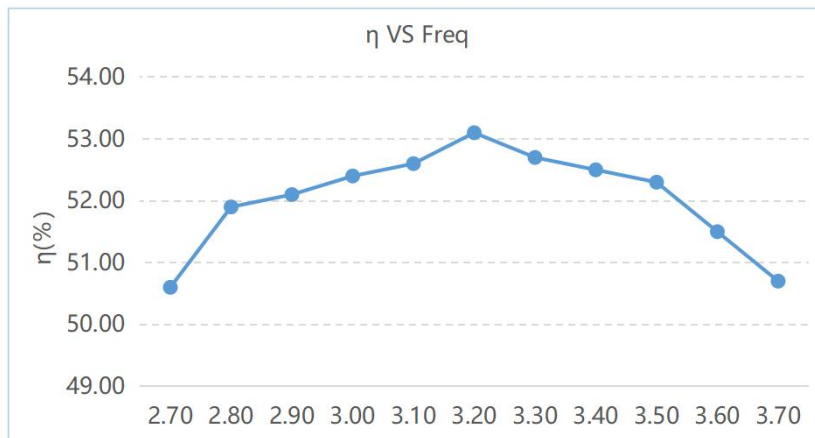
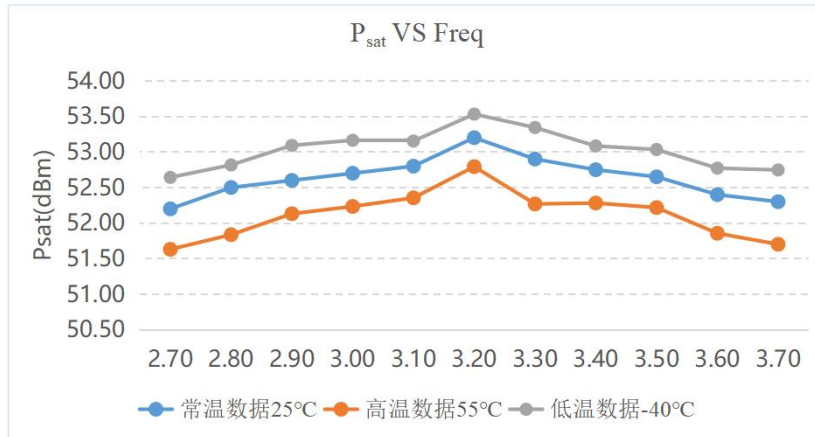
**最大额定值（TC=25℃，不推荐在此条件下工作）：**

参数	符号	值	单位
漏源电压	$V_{DS}$	40	V
栅源电压	$V_{GS}$	-5	V
存储温度	$T_{stg}$	-65 to +150	°C
沟道温度	$T_{ch}$	150	°C

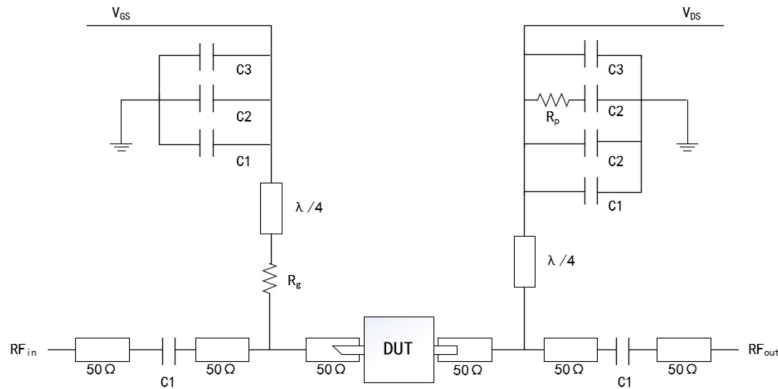
**微波电性能：**

参数	符号	测试条件	值			单位
			Min	Typ	Max	
漏极电流	$I_{dsr}$	$V_{DS}: 32\text{V}$	-	9.9	-	A
饱和输出功率	$P_{sat}$	脉冲工作	52	-	-	dBm
功率增益	$G_p$	$T=1\text{ms}, \text{Duty}=10\%$	12	-	-	dB
工作效率	$\eta$	$\text{Pin}: 40\text{dBm}$	50	-	-	%
增益平坦度	$\Delta G$	$\text{Freq}: 2.7\sim 3.7\text{GHz}$	-0.8	-	0.8	dB

典型曲线



**推荐应用电路：**



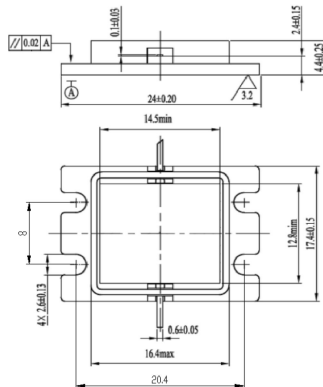
**DUT：待测器件**

- C1: 8pF
- C2: 1000pF
- C3: 100uF
- Rp: 51Ω
- Rg: 15Ω

**防静电等级：**

ESD	Class III	2000V
-----	-----------	-------

**外观尺寸：**



**使用注意事项：**

- 运输存储过程中注意干燥。
- 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯。
- 加电时先加栅电再加漏电。